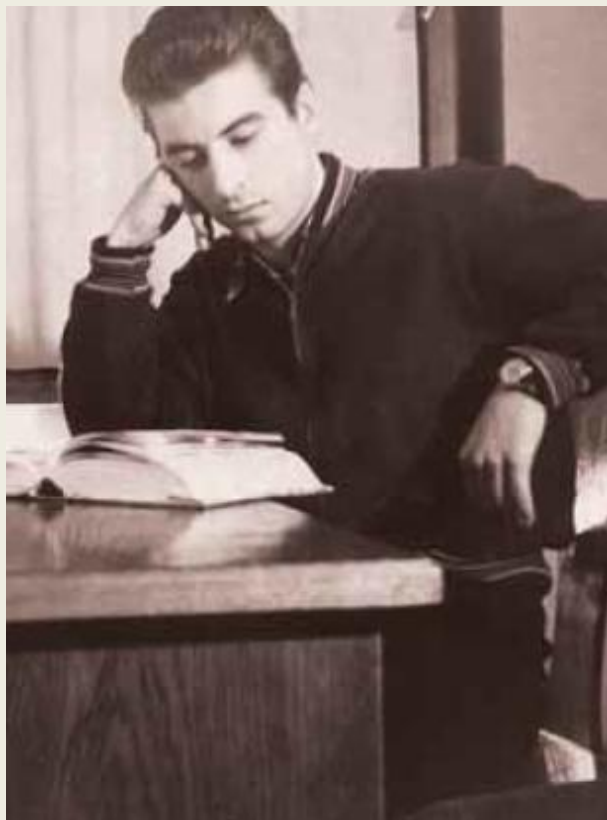


*Виктор Анатольевич Катулин
к 90- летию со дня рождения*



(3 мая 1936 г- 28 сентября 1998 г)

Виктор Анатольевич Катулин – блестящий ученый и талантливый организатор науки, дважды лауреат Государственной премии в области науки и техники, доктор физико-математических наук, профессор, основатель и первый директор филиала ФИАН в г. Куйбышеве (Самаре), основатель и первый заведующий кафедры оптики и спектроскопии Куйбышевского (Самарского) государственного университета родился 3 мая в 1936 году в г. Байрам-Али Туркменской ССР.

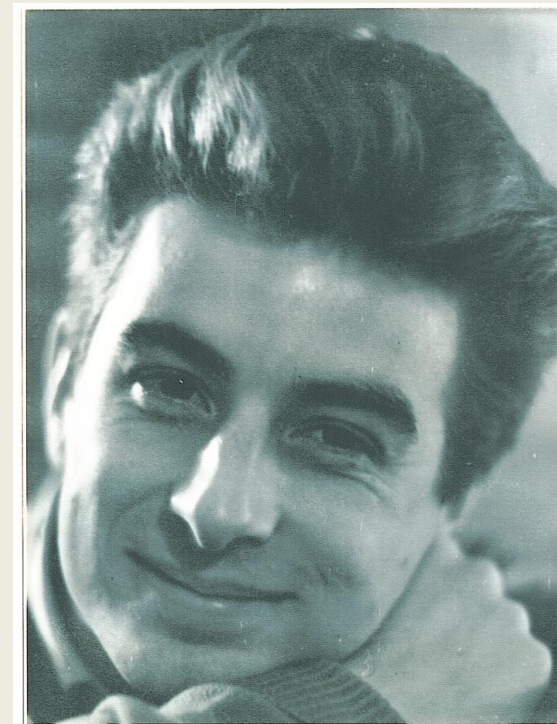


Катулин – студент



В 1960 г. В.А. Катулин закончил физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Три года по окончании университета проработал в Институте физики атмосферы АН СССР (г. Москва), а с 1963 года до самой смерти в 1998 году жизнь Виктора Анатольевича неразрывно связана с Физическим институтом им. П.Н. Лебедева Академии наук (ФИАН).



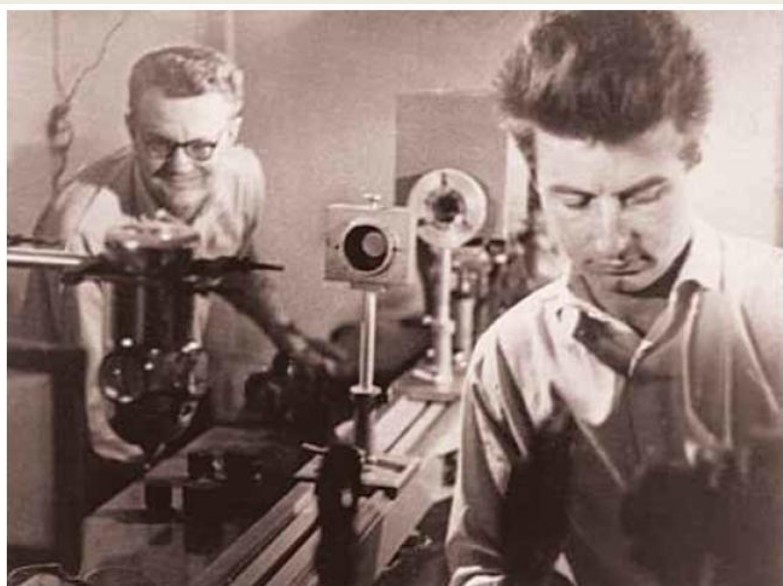
Начало 60-х

Свой трудовой путь В.А. Катулин начал в ФИАНе в лаборатории Нобелевского лауреата Н.Г. Басова.

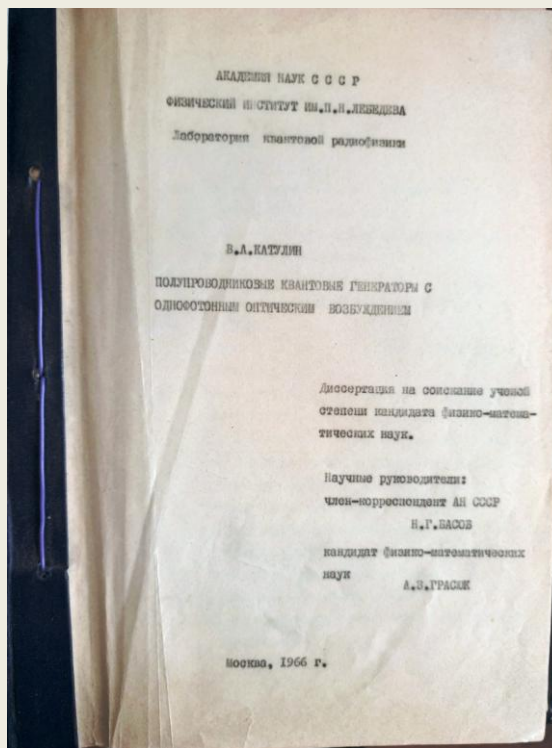


Начало 60-х

В.А. Катулину принадлежит решающий вклад в создании и исследованиях первых в мире полупроводниковых лазеров с однофотонной и двухфотонной оптической накачкой. Впервые в мире была продемонстрирована возможность использования полупроводников в качестве преобразователей лазерного излучения с высоким коэффициентом полезного действия. Публикации по этой тематике имели широкий резонанс, а одна из статей, по двухфотонному оптическому возбуждению арсенида галлия, вошла в десятку самых высокоцитируемых за 1965-1975 гг.



Виктора Катулина называли экспериментатором от бога



Кандидатская диссертация «Полупроводниковые квантовые генераторы с однофотонным оптическим возбуждением», 1966 г

ФИЗИКА

Член-корреспондент АН СССР Н. Г. БАСОВ, А. З. ГРАСКОУ,
В. А. КАТУЛИН

**ИНДУЦИРОВАННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В АРСЕНИДЕ ГАЛЛИЯ
ПРИ ОПТИЧЕСКОМ ВОЗБУЖДЕНИИ**

Получение состояний с отрицательной температурой в полупроводниках было предложено и теоретически исследовано в [1-3]. В [4] наблюдалось и экспериментально исследовалось рекомбинационное свечение кристалла GaAs при возбуждении его светом оптического квантового генератора (ОКГ) на рубине. В данной работе излагаются результаты предварительных исследований индуцированного излучения и генерации полупроводникового кристалла GaAs при возбуждении его светом ОКГ на рубине с модулированной добротностью.

Образец (рис. 1) размерами 2×1 мм, толщиной 0,5 мм изготовлен из монокристаллического GaAs. Полупроводящая поверхность образца S_1 , облучаемая светом накачки, совпадала с кристаллографической плоскостью (111). Две перпендикулярные к ней плоскости S_2, S_3 соответствующие кристаллографической плоскости (110), образовывали плоскопараллельный резонатор. Образец крепился к хладопроводу, охлаждаемому жидким азотом. Для удобства юстировки рядом с образцом помещался

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 1 — ОКГ на рубине с модулированной добротностью; 2 — образец (монокристалл GaAs); S_1, S_2, S_3 — отражающие плоскости образца, образующие резонатор; 3 — хладопровод; 4 — Φ — фильтр, не пропускающий света накачки; 5 — спектрограф ИСП-51. \rightarrow направление света накачки; \rightarrow излучение образца

Рис. 2 — Спектральные линии генерации образца (концентрация носителей $2 \cdot 10^{17}$ см $^{-3}$, подвижность 3500 см 2 /в-сек) и инжекционного лазера на p-n-переходе

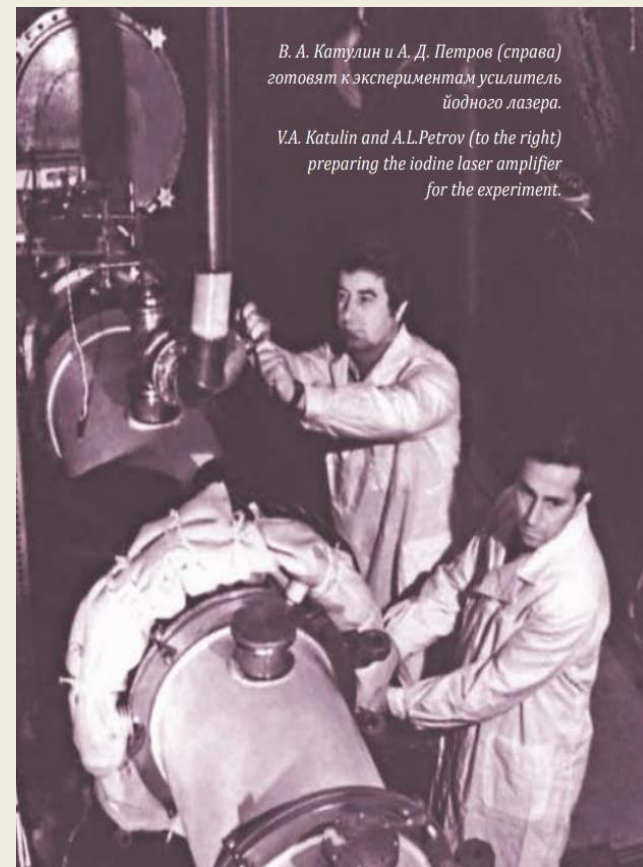
инжекционный ОКГ из арсенида галлия. Излучение от монокристаллического образца GaAs (и ОКГ на p-n-переходе) направлялось в спектрограф ИСП-51. Перед спектрографом устанавливался фильтр Φ , не пропускавший свет накачки ($\lambda = 6943 \text{ \AA}$). Регистрация излучения образца велась либо на фотопленку, либо визуально — с помощью электронно-оптического преобразователя. Энергия импульса излучения ОКГ накачки контролировалась с помощью фотомножителя.

При облучении образца GaAs инфокусированным световым импульсом ОКГ на рубине с энергией около 0,1 дж (мощность 2 Мвт) на выходе спектрографа ИСП-51 наблюдалась суженная спектральная линия

1306

Докл. АН СССР, 1965,
том 161, № 6, 1306–1307

С 1966 года основным направлением исследований В.А. Катулина становится создание мощных газовых лазеров. Коллективом исследователей из разных институтов (ФИАН, ВНИИЭФ, НПО «Астрофизика», ГОИ и др.), в который входила группа молодых физиков-экспериментаторов под руководством Виктора Катулина, были получены уникальные, рекордные характеристики разрабатываемых крупномасштабных йодных лазеров.



Катулин В.А., Носач В.Ю., Баженов А.М., Любченко А.Ю.

1978г

В.А. Катулин и А.Л. Петров и фотоионизационный лазер с открытым разрядом (импульс 1800 Дж длительностью 30 мкс)

За работы по созданию мощных йодных лазеров В.А. Катулин в составе коллектива авторов, внесших основной вклад, в 1980 г. был удостоен Государственной премии СССР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КПСС
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР

от 3 ноября 1980 года

ПРИСУЖДЕНА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ СССР

КАТУЛИНУ

Виктору Анатольевичу—

за работу в области приборостроения.



*Председатель Комитета
по Ленинским и Государственным
премиям СССР
в области науки и техники
при Совете Министров СССР*

(А. АЛЕКСАНДРОВ)

№ 09614

*Ученый секретарь Комитета
по Ленинским и Государственным
премиям СССР
в области науки и техники
при Совете Министров СССР*

(Н. АРЖАНИКОВ)

МОСКВА

Следующим направлением деятельности Виктора Анатольевича Катулина становятся лазеры для термоядерных установок. Катулиным В.А. и возглавляемым им коллективом был создан йодный лазер наносекундных импульсов с оптическим возбуждением излучением открытого электрического разряда непосредственно в лазерной среде. В мировой практике в то время не существовало аналогов таких лазеров. Была показана принципиальная возможность построения крупномасштабной установки для проведения физического эксперимента по лазерному управляемому термоядерному синтезу; развит принципиально новый подход к построению лазеров.



По результатам этих работ В.А. Катулин защитил докторскую диссертацию, «Генерирование и усиление мощных импульсов когерентного излучения с помощью йодных лазеров», а в 1997 году в коллективе авторов получил Государственную премию России за создание мощных импульсных йодных лазерных систем «Искра-4» и «Искра-5» с выходной мощностью излучения до 100 ТВт для исследований в области термоядерного синтеза.

КОМИССИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ПРЕМИЯМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ



МОСКВА



10 " июня 1997 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 1134

Катулин
Виктор Анатольевич

является лауреатом Государственной премии
Российской Федерации в области науки и техники.

Председатель Комиссии
Президент Российской
академии наук

Ю. С. Осипов

НАСТОЯЩИЙ ДИПЛОМ ВЫДАН

ЛАУРЕАТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАТУЛИНУ
Виктору Анатольевичу

Председатель Комиссии при Президенте
Российской Федерации по Государственным
премиям Российской Федерации
в области науки и техники

Ю. С. ОСИПОВ

Учредитель Комиссии при Президенте
Российской Федерации по Государственным
премиям Российской Федерации
в области науки и техники

В. Г. ЖУРАВЛЕВ

№ 1134



ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ
ТЕЛЕГРАММА

Прием: 8:04 - 9 час. 34 мин.

Для записки адресата

Бланк № 000406/4

Получено:

ТЕЛЕГРАММА



МОСКВА 11378371 60 874 0920=

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ МОСКВА ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ 53 ФИЗИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ИМЕНИ П Н ЛЕБЕДЕВА КАТУЛИНУ ВИКТОРУ АНАТОЛЬЕВИЧУ=

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРИСУЖДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1997 ГОДА В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ
ОТ ДУШИ ЖЕЛАЮ ВАМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ БОЛЬШОГО СЧАСТЬЯ И НОВЫХ
ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ НА БЛАГО НАШЕЙ РОДИНЫ=и о министра науки
И ТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АКАДЕМИК В ФОРТОВ-
0922

НННН 0934 08.04 0004

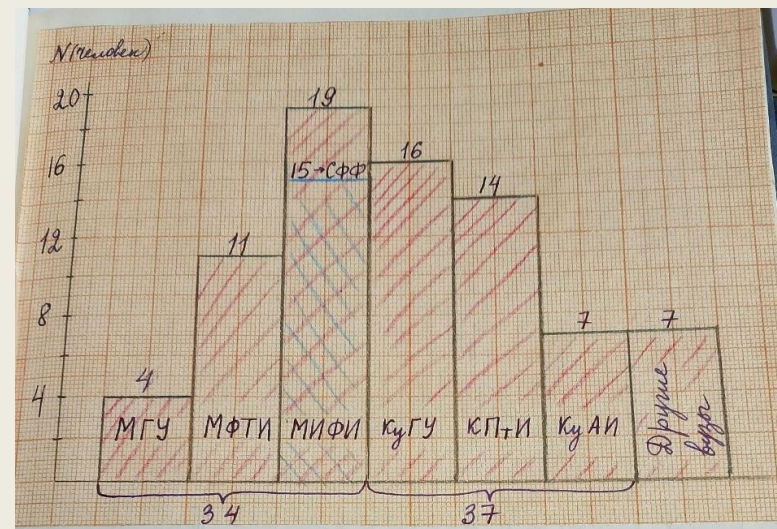
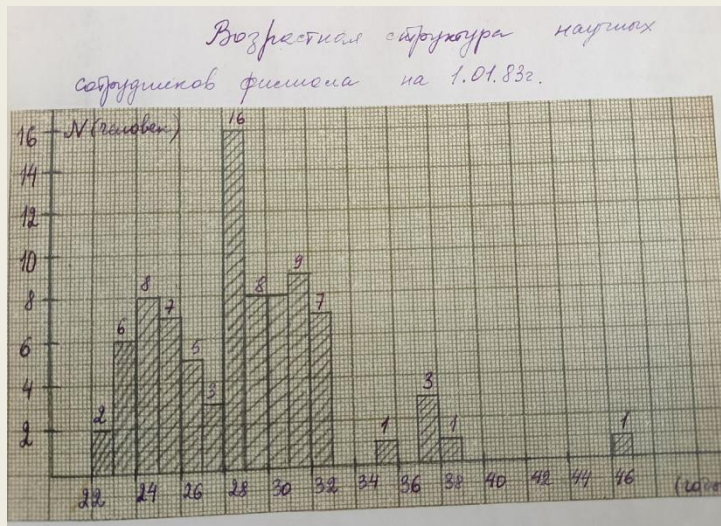
Первыми научными сотрудниками филиала были в основном выпускники московских вузов МИФИ, МГУ, МФТИ. Молодой коллектив сотрудников под руководством Катулина В.А. провел титаническую работу: за короткий срок филиал был обеспечен установками, производственными площадями, сформирован творческий работоспособный коллектив. Были получены новые научные результаты по лазерной технологии и технологическим лазерам, решены актуальные фундаментальные и инженерные задачи, установлено плодотворное сотрудничество с вузами и предприятиями, НИИ как в нашей стране, так и за рубежом.



ул. Садовая, 61 – первый адрес



ул. Потапова, 78 – второй корпус



На 04.02.1983



Встреча «десанта» ученых из ФИАН
в Куйбышеве, 1980 г



Директор ФИАН Н.Г. Басов в
Куйбышевском филиале

Подобно лазерному лучу, Катулин обладал огромной энергией, напором и целеустремленностью в достижении цели. Его трудолюбие, умение брать на себя ответственность за дело и людей, доброта и отзывчивость позволили В.А. Катулину и собранному им молодому коллективу, проделать огромную работу по созданию и развитию института. Сотрудники отмечали его исключительную надежность: верность долгу, слову, дружбе, товариществу. "За ним - как за каменной стеной" - неоднократно повторяли его сотрудники и друзья. И все эти замечательные качества можно объединить одним определением: любовь к людям.



Решением Государственного комитета СССР по науке и технике и Президиума Академии наук СССР в Куйбышеве создан филиал Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН). Создание филиала в Куйбышеве и именно филиала Физического института им. П. Н. Лебедева не случайно.

Находящийся в Москве институт является флагманом советской науки. Он ровесник Российской Академии наук, созданной при Петре I, и как и Академия, недавно отметил свой 350-летний юбилей. В ФИАНе проводятся широким фронтом фундаментальные научные исследования от микромира до космоса, от миниатюрных приборов, различных через микроскоп, до огромных установок, помещающихся в отдельных больших залах.

Результаты проводимых в ФИАНе исследований находятся на очень высоком уровне и признаны во всем мире. Достаточно сказать, что нескольким сотрудникам ФИАНа была присуждена Нобелевская премия. Несколько десятков человек являются лауреатами Ленинской и Государственной премий СССР. Здесь работает ряд академиков и членов-корреспондентов АН СССР.

Научный потенциал ФИАНа огромен и он, в принципе, способен обеспечить высококвалифицированными научными кадрами вновь создающиеся институты, что время от времени и происходит — выделяются из ФИАНа институты, например, Институт радиоэлектроники АН СССР.

С другой стороны, в Куйбышеве давно назрела необходимость создания академического института с широким

профилем научных исследований. Для этого есть все условия: наличие университета, технических вузов и мощной промышленности. Университет — хорошая база для подготовки высококвалифицированных физиков-исследователей для филиала и научных организаций города. Технические вузы — хорошие партнеры при разработке проблем прикладного характера для внедрения в производство. А промышлен-

сти. Имеются лазеры, излучение которых видимо глазом, есть лазеры с невидимым излучением, как в инфракрасной области спектра, так и в ультрафиолетовой. Есть лазеры с таким качеством излучения, что освещенное им пятно на Луне составляет всего несколько километров. Существуют лазеры, мощность которых превышает мощность нескольких электростанций, таких, как Волжская ГЭС им. В. И.

основе разработать промышленную технологию лазерного воздействия: во-вторых, на основе лабораторных лазерных установок разработать надежные, долговечные промышленные лазерные линии для использования в промышленности. Эти задачи будут для института основными. Понятно, что их невозможно решить без фундаментальных, теоретических и экспериментальных исследований в лабораториях. Вот почему

мы эту задачу решаем комплексно. Для строительства комплекса научно-административных зданий выделен участок на берегу Волги, определенная строительная организация, имеется разработанный проект здания, и мы надеемся в ближайшее время начать строительство. Планируется к концу 12-й пятилетки создать институт с рабочей площадью около 50 тысяч квадратных метров и численностью сотрудников

СОЗДАН НОВЫЙ ИНСТИТУТ

ность — это та благоприятная почва, на которой посеянные семена результатов научных исследований дают высокий урожай экономического эффекта.

Для окончательного решения вопроса о создании Куйбышевского филиала ФИАНа в Куйбышев выезжала в 1978 году представительная комиссия АН СССР под руководством вице-президента Академии наук СССР, академика Котельникова В. А. и директора ФИАНа, лауреата Ленинской и Нобелевской премий, Героя Социалистического Труда, академика Басова Н. Г. Комиссия рекомендовала АН СССР создать в Куйбышеве академический институт.

Какие задачи поставлены перед институтом?

Бурное развитие квантовой радиофизики привело к созданию очень широкого спектра лазеров по виду излучения, его качеству и мощно-

сти. Правда, длительность импульса их излучения составляет всего одну миллионную долю секунды. Имеются лазеры, которые действуют непрерывно и могут резать сталь толщиной до 5—10 миллиметров с большой скоростью.

Исследования показали, что применение лазеров в технике, промышленности и медицине дает огромный экономический эффект, исчисляемый десятками миллионов рублей. Кроме того, лазеры наряду с ускорением процессов позволяют решать принципиально новые задачи: например, бесконтактную диагностику испытываемых объектов на расстоянии, обработки поверхностей деталей, для которых недопустима малейшая деформация и др.

Чтобы осуществить эти задачи, нужно решить в крайней мере такие проблемы: во-первых, изучить взаимодействие лазерного излучения с веществом и на его

мы наряду с экспериментальными лабораториями создаем теоретический отдел с вычислительной техникой.

Институтом будут проводиться также фундаментальные исследования с целью дальнейшего совершенствования разработанной под руководством академика Басова Н. Г. и главного конструктора профессора Бережного И. А. на одном из куйбышевских предприятий лазерной посадочной системы «Глиссада». В частности, будут продолжаться исследования путей увеличения дальности действия системы в тумане посредством просветления каналов непрерывным или импульсным лазерным излучением большой мощности инфракрасного диапазона.

Конечно же, для осуществления этой программы нам нужна поддержка местных партийных и советских организаций, а также научной общественности города и области. В настоящее время

около 2.500 человек, в состав которого войдут также конструкторское бюро в опытное производство.

Ядро коллектива научных сотрудников созданного филиала составят высококвалифицированные молодые доктора и кандидаты наук — все воспитанники ФИАНа. На административные должности, инженерно-технические, лаборантские мы будем приглашать местные кадры. В дальнейшем надеемся воспитывать собственные кадры на базе университета с последующей стажировкой, выполнением вдумных работ и обучением в аспирантуре на базе филиала ФИАН и Московского ФИАНа.

В. КАТУЛИН.

Директор

Куйбышевского филиала Физического института им. П. Н. Лебедева, доктор физико-математических наук.

ЛАЗЕРНЫЙ КОМПЛЕКС У ВОЛГИ

В НАШЕМ городе создан филиал Физического института имени П. Н. Лебедева Академии наук СССР. Это первое академическое учреждение в Куйбышеве и первый филиал старейшего физического научно-исследовательского института страны (ФИАН ведет свое начало от физического кабинета, созданного в Петербурге в 1725 году и включенного в состав Академии наук). Исследования, ведущиеся в лабораториях и отделах ФИАНа, охватывают все наиболее важные разделы физики. Ряд открытий сделан в институте в области квантовой электроники. Свое слово в ее развитии призван сказать и новый филиал ФИАНа в Куйбышеве.

Прежде чем взять интервью у директора Куйбышевского филиала физического института имени П. Н. Лебедева АН СССР В. А. Катулина, несколько слов об ученом. Виктор Анатольевич — доктор физико-математических наук, в 1960 году окончил физфак МГУ, кафедру оптики и стал сотрудником Института физики атмосферы АН СССР. С 1963 года по приглашению лауреата Ленинской и Нобелевской премий академика Н. Г. Басова начал работать под его руководством в лазерной лаборатории ФИАНа.

— Виктор Анатольевич, с чего начинается филиал ФИАНа в Куйбышеве?

— Прежде всего, с помощи, с активной поддержки партийных, советских органов, университета и ряда других организаций. Создание такого филиала — обоюдное желание города, где мы — первое академическое подразделение, и нашего института, впервые создающего свое отделение. Желание это понятно: квантовая электроника послужит дальнейшему прогрессу различных отраслей промышленности, достижения науки придут на помощь производству, а серьезные научные исследования в свою очередь весьма перспективно вести в крупном промышленном центре, располагающем техническими вузами и университетом.

Филиал начинается с высадки на волжские берега московского «научного десанта» — группы молодых физиков, воспитанников ФИАНа, кандидатов наук, творческих, держащих исследователей. Они — ядро, костяк коллектива. Пока нам предоставлено двухэтажное здание, места для theoretиков, для группы с мощными лазерами дает университет. В ближайшее время предполагается начать строительство комплекса зданий института на берегу Волги. Лазерный комплекс расположится неподалеку от университета.

— Очевидно, это не случайное соседство...

— Думается, нас с университетом будут связывать не просто добрососедские отношения — кровное родство. Я приглашен в КГУ возглавить новую кафедру оптики.

И, не скрою, намерен смотреть на студентов «с дальним прицелом», как на потенциальных сотрудников нашего филиала. Мы планируем вести целенаправленный поиск среди школьников, студентов, чтобы выявить одаренных, пытливых молодых людей с исследовательской «изюминкой». Будем их расти-

вать, воспитывать высококвалифицированные научные кадры — свои, куйбышевские. А повысить квалификацию молодым исследователям помогут направления в московские аспирантуры, на стажировку в ФИАН. Думаю,

у нас наладятся тесные контакты и с другими вузами, научными организациями, в перспективе возможно создание совместных проблемных лабораторий. Почва для такого сотрудничества уже есть, между ФИАНом и различными организациями города творческие связи установились и крепнут.

— Каковы основные направления деятельности волжского филиала ФИАНа?

— Это и фундаментальные исследования, и работы прикладного характера. Мы будем заниматься лазерами. Одна из наиболее важных задач — внедрение лазерной технологии в промышленность. Ведь с помощью лазеров возможны сварка, закатка, резка и сверление различных материалов без возникновения в них механических напряжений, неизбежных при обычной обработке, плюс очень высокая точность. Предстоит создание технологических лазерных установок для легирования и упрочнения поверхностей металлов.

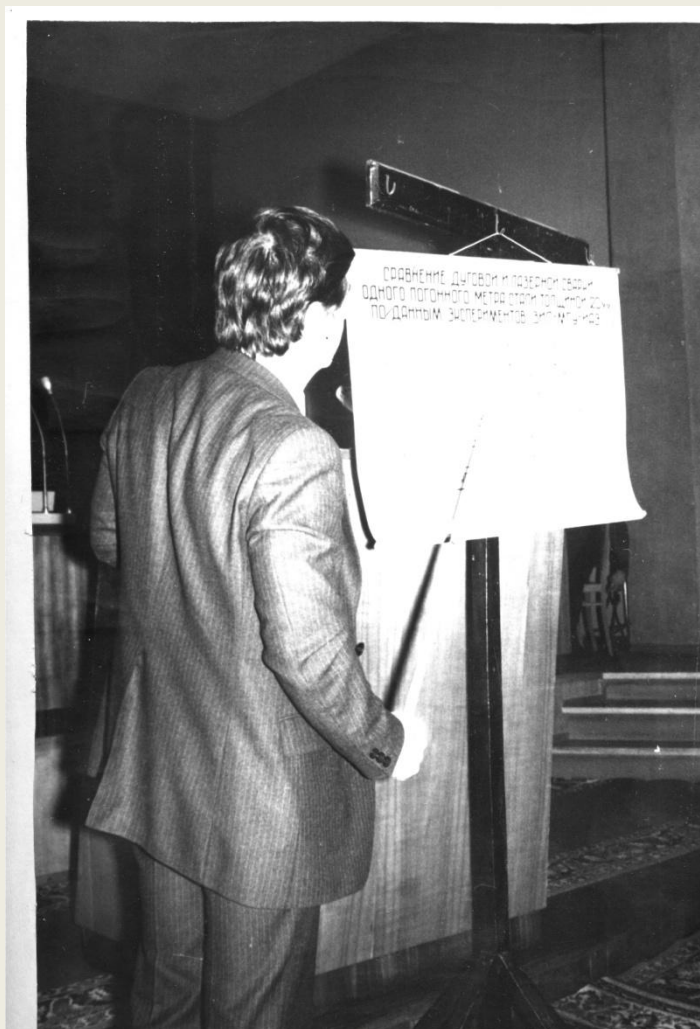
Я был на ВАЗе, к лазеру проявляют очень большой интерес автомобилестроители. Весьма показателен опыт применения промышленной установки для лазерной закатки заднего моста автомобиля «Москвич». До ее внедрения именно на задний мост предприятие получало немало рекламаций. Лазерная закатка помогла во много раз повысить прочность. Сейчас лазерную технологию думают внедрить в производство и вазовцы. У лазера самые широкие перспективы применения в различных отраслях промышленности.

Думается, с развитием деятельности института установятся наши контакты и с медиками. Уже сейчас лазеры успешно применяются в офтальмологии, например, при операциях на сетчатке глаза как скальпели, да и в терапии — тоже, в частности, для заживления язвы желудка.

Интенсивно развиваются методы лазерной локализации, связи, геодезических измерений. Словом, спектр действия оптических квантовых генераторов самый широкий. Предстоят исследования и самих лазеров — их возможностей, качеств, свойств, создание новой аппаратуры. Много «профессий» у лазера — может быть еще больше.

Интервью взял
А. СОХРИНА.

Научно-практический семинар «Лазеры и их применение», 4 ноября 1980г

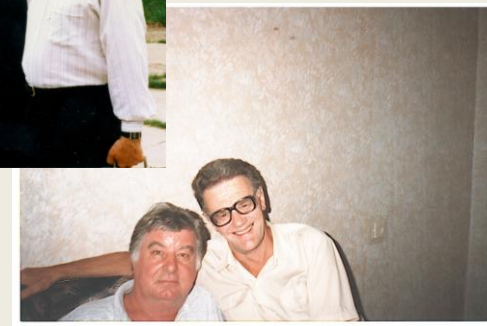


Первый доклад директора

В 1980 г. было принято решение о создании в Куйбышевском университете новой кафедры – кафедры оптики и спектроскопии, возглавил которую директор филиала ФИАН В.А. Катулин. Все ведущие ученые филиала и молодые сотрудники начали работать на кафедре оптики и спектроскопии – читать лекции, руководить научно-исследовательской работой студентов. Для чтения отдельных курсов лекций приглашались ученые из Москвы.



Кафедра оптики и спектроскопии. Слева направо: А.Л. Петров, М.В. Лудина, Н.Н. Алятина, В.В. Ивахник, В.А. Катулин, С.П. Котова, В.И. Игошин, И.Л. Ключац, В.С. Казакевич.



Друг и соратник В.А. Катулина А.З. Грасюк читал курс лекций по лазерному взаимодействию с веществом и в МГУ им. М.В. Ломоносова, и в нашем университете, и долгие годы был председателем ГЭК, высоко оценивая уровень дипломных работ выпускников Самарского университета.

Тесное сотрудничество СФ ФИАН с университетом продолжается и сегодня.



Свое 10-летие филиал встречал в новом здании на Ново-Садовой, 221, и к тому моменту коллектив уже мог гордиться многими своими результатами.

- Разработан и изготовлен единственный в мире прототип промышленного импульсно-периодического электроионизационного СО-лазера замкнутого цикла.
- Теоретически разработаны новые физические принципы создания импульсных химических лазеров, основанных на явлении фотонного разветвления цепной реакции и термоцепного взрыва.
- Разработаны и успешно внедряются в промышленность технологии лазерной сварки.
- Ведутся работы по разработке химического кислородно-йодного лазера.
- Найден и экспериментально реализован новый класс пучков, названных спиральными, исследовать фундаментальные свойства и открыть уникальные приложения которых, еще предстояло.



ул. Ново-Садовая, 221 - современное здание филиала



Директор Куйбышевского филиала в рабочем кабинете

Гости филиала



Участие в конференциях в СССР и за рубежом



Япония



Германия





Ученый совет 1991 г



С космонавтом Титовым 23 сентября 1992 г

Присущие Виктору Анатольевичу жизненная активность и компетентность позволяли ему плодотворно и естественно сочетать руководство научно-исследовательским институтом с заведованием кафедрой оптики и спектроскопии Самарского государственного университета, возглавлять в течение 15-ти лет Правление областного общества "Знание", являться председателем и членом ряда научных советов, в частности, членом Президиумов Самарского научного центра и Поволжского отделения Инженерной академии наук, Межведомственного научно-технического совета по проблемам лазерной технологии при Президиуме АН СССР и ГКНТ.

Диплом

№ 247

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ

избрала

ПРОТОКОЛ № 1 17 ДЕКАБРЯ 1991 Г.

КАТУЛИНА

ВИКТОРА АНАТОЛЬЕВИЧА

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ЧЛЕНОМ



ПРЕЗИДЕНТ

Б. ГУСЕВ

ГЛАВНЫЙ УЧЕНЫЙ
СЕКРЕТАРЬ

А. ЯКОВЛЕВ



МОСКВА

Грамоты и поздравительные адреса В.А. Катулину в честь 50-летия (1986 г)

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН,СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

НАГРАЖДАЕТСЯ

КАТУЛИН ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, заведующий кафедрой оптики и спектроскопии, профессор, за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую работу, подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 50-летием со дня рождения.

Ректор

Секретарь парткома

Председатель профкома



Л.В. Храмков

А.П. Овчинников

В.Я. Мачнев



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

П РА В Л Е Н И Е
О Б Щ Е Ш Т В А «З Н А Н И Е» Р С Ф С Р
Н А Г Р А Ж Д А Е Т

КАТУЛИНА

Виктора Анатольевича

за активное участие в совершенствовании лекционной пропаганды среди трудящихся Куйбышевской области и в связи с 50-летием со дня рождения



Председатель правления

Москва 27 " 03 19 86 года

Уважаемый Виктор Анатольевич!

От имени коллектива производственного объединения ГПЗ-4 сердечно поздравляем Вас со знаменательным юбилеем—

50-летием со дня рождения!

Мы знаем Вас как крупного ученого, автора принципиально новых теоретических разработок в области лазерной техники. Ваша деятельность по достоинству оценена Родиной—присуждением Вам звания лауреата Государственной премии СССР.

Вы всегда, находясь на острие технического прогресса, уверенно возглавляете его развитие у нас в стране и странах СЭВ, являясь руководителем 3-х лазерных программ сотрудничества между Академиями наук СССР, ГДР и ЧССР.

Ваша активная жизненная позиция способствует скорейшему внедрению лазерной технологии в нашем регионе.

Велика заслуга Куйбышевского филиала Физического института Академии наук СССР, возглавляемого Вами, во внедрении на нашем объединении новых технологических процессов лазерной обработки.

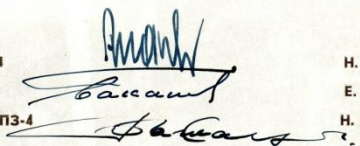
Вам наша сердечная признательность и рабочая благодарность за все сделанное Вами и что будет сделано на благо нашей Родины.

В день Вашего пятидесятилетия от души желаем Вам, Виктор Анатольевич, крепкого здоровья, хорошего настроения, личного счастья, присущей Вам неиссякаемой энергии и бодрости, многих лет плодотворной работы.

Генеральный директор ПО ГПЗ-4

Секретарь парткома завода

Председатель завкома ПО ГПЗ-4



Н. П. РУДАКОВ

Е. М. БАКАНОВ

Н. В. ДОРОХИН

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЙ Виктор Анатольевич!

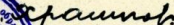
Коллектив профессоров, преподавателей, сотрудников и студентов Куйбышевского государственного университета сердечно поздравляет Вас с юбилеем— 50-летием со дня рождения.

Возглавляя одно из наиболее перспективных направлений квантовой электроники и лазерной техники, разработка которого отмечена Государственной премией СССР, Вы совмещаете активную научную работу с руководством кафедрой оптики и спектроскопии госуниверситета, передаете свой огромный опыт исследователя молодым ученым и студентам.

Ваша плодотворная творческая деятельность не ограничивается рамками одной лишь академической науки. Вы являетесь председателем правления областной организации общества „Знание“. Будучи депутатом областного Совета народных депутатов, много времени и сил Вы отдаете работе с избирателями.

Мы благодарны Вам, дорогой Виктор Анатольевич, за Ваш неутомимый труд—труд талантливого ученого, замечательного организатора и воспитателя молодого поколения.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, большого счастья в жизни, новых творческих успехов.

Ректор университета  Л. В. ХРАМКОВ

Секретарь парткома  А. П. ОВЧИННИКОВ

Председатель профкома  В. Я. МАЧНЕВ



Научное наследие Виктора Анатольевича Катулина включает более 150 научных работ, созданные при его активном участии уникальные приборы и экспериментальные установки, разработанные новые принципы создания лазеров, полученные рекордные характеристики созданных лазерных систем. Но любое научное наследие включает научную школу — учеников и последователей. Трудно переоценить вклад, который внесло в развитие физических наук в нашем регионе создание СФ ФИАН, организация кафедры оптики и спектроскопии

Сегодня в Самарском филиале ФИАН 5 научных подразделений, в котором работают более 50 научных сотрудников. Среди основных направлений: разработка лазеров, в том числе новых мощных лазеров с дифракционным качеством излучения, лазерное упрочнение и термообработка материалов, наноскопы и лазерные пинцеты на основе структурированных световых полей, синтез новых функциональных материалов и структур с заданными свойствами, газодинамика и магнитогазодинамика тепловыделяющих сред. Последние годы большие успехи достигнуты в области астрохимии и астрофизики. По-прежнему, СФ ФИАН продолжает работать в тесном сотрудничестве с университетом.

Приток последние годы молодых сотрудников в СФ ФИАН, высокий уровень студентов и аспирантов, подтверждаемый публикациями в высокорейтинговых журналах, выигранные конкурсы для молодых ученых на региональном и всероссийском уровнях, защиты кандидатских диссертаций позволяют надеяться, что дело В.А. Катулина продолжается, у созданных им Самарского филиала ФИАН, кафедры оптики и спектроскопии хорошее будущее с яркими научными результатами, актуальными прикладными разработками.

Новые результаты, новые имена в науке – это лучшая память о человеке, внесшим значимый вклад и в мировую физику, и в развитие науки в Самаре – Викторе Анатольевиче Катулине.